

# Silicon - Diode

## **BY299**

800V / 2A

# DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 74/75

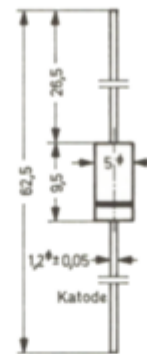
## BY 296 ... BY 299

### Schnelle Silizium-Gleichrichter

Nennstrom	2 A
period. Spitzensperrspannung	100...800 V

Kunststoffgehäuse  $\approx$  DO-13  
Gewicht ca. 1 g  
Maße in mm

In listenmäßiger Ausführung werden diese Gleichrichter gegurtet geliefert. Näheres siehe unter „Gurtung“.



### Grenzwerte

Typ	periodische Spitzensperrspannung $U_{RRM}$ V
BY 296	100
BY 297	200
BY 298	400
BY 299	800

Nennstrom in Einwegschaltung mit Widerstandslast bei $T_U = 50$ °C	$I_{FAV}$	2 <sup>1)</sup>	A
periodischer Spitzenstrom bei $\theta < 40^\circ$ , $f > 15$ Hz	$I_{FRM}$	10	A
Stoßstrom für eine 50-Hz-Sinus-halbwellen ausgehend von $T_J = 25$ °C	$I_{FSM}$	70	A
Sperrschichttemperatur	$T_J$	150	°C
Betriebs- und Lagerungstemperaturbereich	$T_U, T_S$	-40...+150	°C

1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

## BY 296 ... BY 299

### Kennwerte

Durchlaßspannung bei $I_F = 3 \text{ A}$ , $T_J = 25 \text{ °C}$	$u_F$	<1,3	V
Sperrstrom bei $U_{RRM}$ , $T_J = 25 \text{ °C}$	$I_R$	<10	$\mu\text{A}$
Durchlaßverzögerung bei $I_F = 100 \text{ mA}$	$t_{fr}$	<1	$\mu\text{s}$
Sperrverzögerung beim Umschalten von $I_F = 10 \text{ mA}$ auf $I_R = 10 \text{ mA}$ bis $I_R = 1 \text{ mA}$	$t_{rr}$	<0,5	$\mu\text{s}$
Wärmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft	$R_{thU}$	<35 1)	K/W

1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.